

INVESTOR RELATIONS 2025

기술로 기회를 가치로 만드는
제이아이테크



Disclaimer

본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 PRESENTATION에서 정보 제공을 목적으로 주식회사 (주)제이아이테크(이하 ‘회사’)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드립니다. 본 PRESENTATION에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 ‘예측정보’는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 ‘예측정보’는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 ‘예측정보’에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 미래 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함). 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

Contents

Chapter 1.
Company Overview

Chapter 2.
Business area

Chapter 3.
Growth Strategy

Chapter 4.
Appendix



Chapter 1.

Company Overview

1. 회사 개요
2. 사업장 현황
3. 자회사 현황
4. 설비투자 현황
5. 연구인력 및 보유기술, 특허권 현황

JI TECH BOASTS OUTSTANDING
TECHNOLOGY AND PRODUCTS



01 회사 개요

- 회사 개요

회사명	(주)제이아이테크
설립일	2014년 3월 28일
자본금	32.8억원 (2024.12.31기준)
임직원	130명 (2024.12.31기준)
주요 사업	- PRECURSOR for Semiconductor - PHOTOMASK CASE for FPD - OLED MATERIALS
본사 및 자회사	- 본사 및 연구소: 전라북도 군산시 - JITECH India Pvt. Ltd : 인도 텔랑가나주 하이데라바드 - JI CarbonX : 전라북도 군산시 - JI SPECIALTY : 전라북도 군산시
홈페이지	www.ji-tech.co.kr

- CEO Profile

전자재료 소재 전문 기업
제이아이테크 리더

함석헌 대표이사

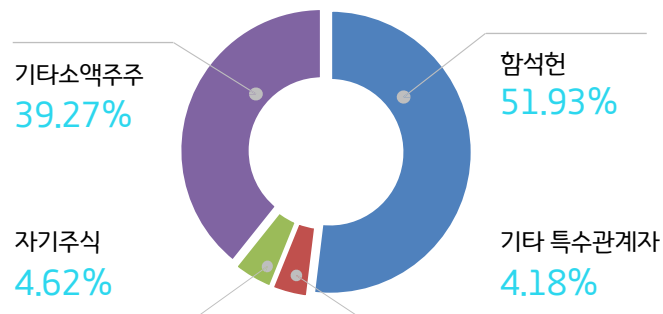
現) (주)제이아이카본엑스 대표
前) (주)한솔케미칼
前) (주)유피케미칼



- 지배구조

	99.98%	JITECH India Pvt. Ltd
(주)제이아이테크	93.13%	(주)제이아이카본엑스
	51.00%	(주)제이아이스페셜티

- 주주구성



- 2024년 12월말 기준

02 사업장 현황

1st 공장 : 본사

위치

군산시 중가도길 16

시설현황

본사 사무실
프리카서 제조시설 및 창고
연구소 및 품질관리실
PMC 제조시설

면적

10,780 m²



2nd 공장

위치

군산시 무역로 30

시설현황

프리카서 제조시설 및 창고
OLED 승화 시설
OLED 합성 및 정제시설

면적

13,222 m²



3rd 공장

위치

군산시 새만금산단

시설현황

MCS & DCS 소분 시설
신규 프리커서 제조시설(예정)
탄산리튬 제조시설(예정)

면적

31,508 m²



03 자회사 현황

JITECH India Pvt. Ltd

위치

인도 텔랑가나주 메닥 지
구 체쿤타시

시설현황

프리커서 및 OLED 소재 제조시설
R&D 센터
품질관리실

면적

40,463 m²

지분율

99.98%

사업현황

- 반도체 및 OLED 재료 원자재 및 중간체 생산 플랜트 건설
- 25년 총 생산동 7개동 중 1개동 및 전체 7개동 사용을 위한 유틸리티, 공용 시설 6월 완공 예정)
- 주요 생산품 : n-Butyllithium, Precursor, OLED 재료



(주)제이아이카본엑스

위치

군산시 새만금산단

시설현황

CCU 상용플랜트

면적

15,200 m²

지분율

93.13%

사업현황

- 고품질 액화탄산가스 생산(4N : 99.99%)
- 2024년 준공, 현재 일 약 115t 생산 중
- 주요 생산품 : 공업용 및 식음료용 액화탄산가스, 드라이아이스



[포집동]

[액화동]



04 설비투자 현황

단위:백만원

구 분		Actual						Plan		
		FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	Total	FY2025	FY2026	FY2027
JITECH	1공장	316	1,974	768	3,519	1,611	8,188	2,000	-	-
	2공장	1,837	2,622	3,857	7,719	13,381	29,416	7,500	1,000	-
	3공장	-	-	-	-	9,187	9,187	2,000	5,000	5,000
	소 계	2,152	4,597	4,625	11,238	24,178	46,791	11,500	6,000	5,000
JITECH India Pvt. Ltd		-	-	244	2,685	6,069	8,998	5,000	8,000	8,000
제이아이카본엑스	CCU 포집 및 액화 설비	-	-	-	18,189	611	18,800	800	500	-
합 계		2,152	4,597	4,869	32,112	30,858	74,588	17,300	14,500	13,000

Actual

- 1공장 : 프리커서 제조시설, R&D 센터, 품질분석실
- 2공장 : 프리커서 제조시설, OLED 승화시설
- 3공장 : 원재료 소분시설
- JITECH India Pvt. Ltd : 프리커서 & OLED 재료 제조(PB1)
- (주)제이아이카본엑스 : CCU 포집 및 액화설비

Plan

- 1공장 : 신규 R&D 센터 구축
- 2공장 : 신규 프리커서 제조시설, OLED 합성&정제 시설
- 3공장 : 신규 프리커서 제조시설, 탄산리튬 설비 구축
- JITECH India Pvt. Ltd : 반도체용 전자 재료 제조(PB2~PB7)

05 연구인력 및 보유기술, 특허권 현황

R&D 연구 인력 현황



19명
(전체 인력의 15%)

2024년
정부지원 연구과제
3개 진행

삼성 공동 연구에 따른 IGZO “journal of material chemistry”에 2편 게재

* IGZO : 인듐(In), 갈륨(Ga), 아연(Zn) 프리커서를 혼합하여 ALD 방식 증착. 디스플레이 산화물 반도체로 응용하기 위해 개발



다양한 소재 기술 및 제품 개발

전체 등록특허권 12건 (5건 출원 중)

주요 특허내역

1. Si-O 결합을 갖는 화합물을 포함하는 첨가제 및 이를 포함하는 실리콘 중합체 합성용 조성물
2. 수소-규소 결합의 안정성 개선을 위한 첨가제
3. 페닐 계열의 수소-규소 결합의 안정성 개선을 위한 첨가제
4. 포토 마스크 보관 케이스용 대전 방지시트, 이의 제조 방법, 및 대전 방지 특성의 회복 방법
5. 성막용 유기금속 전구체의 제조방법(출원중)
6. 리튬화합물 반응 폐기물을 이용한 고순도 탄산리튬의 신규한 제조방법(출원중)

Journal of Materials Chemistry C

PAPER



Charge transport properties of high-mobility indium-gallium-zinc oxide thin-film transistors fabricated through atomic-layer deposition

Sang-Joon Park,¹ Se-Ryong Park,¹ Jong Mu Na,¹ Woo-Seok Jeon,¹ Youngjin Kang,² Sukhun Ham,³ Yong-Hoon Kim,⁴ Yung-Bin Chung¹ and Tae-Jun Ha^{1*}

Received 20th August 2024,
Accepted 6th November 2024
DOI: 10.1039/D4TC00560g
rsc.jmatsci-c

Introduction

Indium-gallium-zinc oxide (IGZO) exhibits high carrier mobility, even in its amorphous phase, as well as a low leakage current and good optical transparency.¹ Therefore, it has gained significant interest as an active channel material for thin-film transistors (TFTs), particularly for display backplanes.² Considerable research efforts have focused on improving the quality and performance of displays using IGZO TFT backplanes.³ Consequently, the demand for high-mobility IGZO TFTs as switching/driving components has increased to realize ultrahigh-resolution and high-frame-rate displays.⁴

Various methods have been used to deposit IGZO films, including sputter coating, sputtering, and atomic-layer deposition (ALD).^{5–7} Among these, ALD can be a promising candidate for the formation of high-quality IGZO films with excellent

conformity and low impurity densities, because it involves self-limiting and plasma-free gas-phase chemical reactions.⁸ TFTs with high-quality IGZO films have a high field-effect mobility (μ) and excellent charge transport properties, which can be mainly affected by the material characteristics of the semiconducting films used as the channel layer.⁹ In addition, because ALD does not cause serious physical and/or chemical damage during deposition, it does not induce high densities of interfacial trap states between the channel and dielectric layers and bulk trap states in the channel, resulting in improved charge transport properties, even for the same device configuration.¹⁰ This is because shallow charge trapping at the channel-gate dielectric interface and deep charge trapping within the channel can deteriorate the charge transport properties during the TFT operation.¹¹

The multiple-trapping-and-release model explains the charge transport mechanism in TFTs based on the disordered nature of amorphous channel films.¹² Recently, we fabricated high-performance IGZO TFTs by ALD, which exhibited high linear μ values of up to $15 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, exceeding those of IGZO TFTs fabricated through sputtering or sputter-coatings ($1\text{--}10 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$).¹³ Therefore, the mechanism behind the excellent performance of ALD-based IGZO TFTs, including the high μ values, should be investigated.¹⁴ Notably, a comparative



Journal of Materials Chemistry C

PAPER



Check for updates
Cite this: J. Mater. Chem. C, 2024, 12, 15161

High-quality indium-gallium-zinc oxide films synthesized by atomic layer deposition using a single cocktail precursor based on a liquid-delivery system and their application in transistors and inverters†

Sang-Joon Park,¹ Se-Ryong Park,¹ Woo-Seok Jeon,¹ Jong Mu Na,¹ Jun Hyung Lim,¹ Sukhun Ham,¹ Yung-Bin Chung¹ and Tae-Jun Ha^{1*}

High-quality indium-gallium-zinc oxide (IGZO) films synthesized by atomic layer deposition (ALD) using a single cocktail precursor based on a liquid-delivery system are demonstrated for the first time. A bottom-gate-top-contact thin-film transistor (TFT) consisting of an ALD-derived IGZO channel exhibited outstanding device performance, including a high linear field-effect mobility ($\sim 20 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$), a substantial on/off ratio ($> 1 \times 10^5$), and a low subthreshold swing ($< 0.07 \text{ V dec}^{-1}$) at an operating voltage of 5 V. High reliability and reproducibility of the proposed ALD-derived IGZO TFT are confirmed from the statistics of device key parameters. The operational stability of the IGZO TFT subjected to electrical bias stresses for 2000 s is investigated, which is attributed to the oxygen-related defect states of the ALD-derived IGZO film and the field-induced interaction with oxygen on the surface. In addition, full recovery of V_{th} without additional processes was achieved, indicating that the instability mechanism can be explained by shallow charge trapping at the interface. A simple and effective method of oxygen annealing is induced to improve the operational stability of the IGZO TFT by suppressing the oxygen-related shallow trap states. Finally, an enhancement load-type inverter channel metal-oxide semiconductor inverter consisting of two IGZO TFTs proposed in this study is developed.

Received 8th May 2024,
Accepted 6th July 2024
DOI: 10.1039/D4TC00543E
rsc.jmatsci-c

Indium-gallium-zinc oxide (IGZO) films have garnered substantial attention as active channel layers in thin-film transistors (TFTs), owing to their high carrier mobility even in the amorphous phase, low leakage current density, and favorable environmental stability.¹ Various methods for forming IGZO channel films, such as sputtering, sputter coating, and atomic layer deposition (ALD), have been demonstrated for TFT-based applications.^{2–4} Sputtering has been widely used to achieve IGZO films with good uniformity and reproducibility.⁵ However, limited controllability of thickness and cation composition is challenging to achieve high-quality IGZO films for emerging TFT applications such as display backplanes and logic circuits.⁶

The ALD method, characterized by excellent thickness/composition controllability, low defect states, and high step coverage due to self-limiting and plasma-free gas-phase chemical reactions, has been extensively explored to achieve high-quality IGZO films using metal precursors.⁷ However, issues such as high process complexities, low growth rates, and extended processing times, particularly in the formation of quaternary oxide films, must be addressed to align with industrial requirements.⁸ The uniform and reliable composition of IGZO through ALD presents a challenge, as the different vapor pressures induced by three different metals can significantly affect the process time and batch-to-batch variations.⁹ Furthermore, the growth rate per cycle (GPC) can change significantly, complicating the control of ALD-derived IGZO film thickness.¹⁰

In this study, we demonstrate, for the first time, high-quality IGZO films synthesized through a practical and reliable ALD process using a single cocktail precursor based on a liquid-delivery system and their applications in TFTs and inverters. Material characteristics, including morphology, crystallinity, and oxygen-related binding states, were analyzed to assess the quality of the ALD-derived IGZO films based on process optimization. We also demonstrate bottom-gate top-contact TFTs based on ALD-derived IGZO films with conventional

¹ Department of Electronic Materials Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Republic of Korea. E-mail: tjunha@hanyang.ac.kr
² Tech Co., Ltd., Pohang-do, Korea, Republic of Korea
³ Samsung Display Co., Ltd., Gyeonggi-do 17114, Republic of Korea
⁴ E-mail: yungbin.chung@samsung.com
⁵ E-mail: jayungha@hanyang.ac.kr
⁶ School of Advanced Materials Science and Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Republic of Korea. E-mail: phm@hanyang.ac.kr

[†] Department of Electronic Materials Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Republic of Korea. E-mail: tjunha@hanyang.ac.kr
[‡] Samsung Display Co., Ltd., Gyeonggi-do 17114, Republic of Korea
[§] E-mail: jayungha@hanyang.ac.kr
[¶] E-mail: yungbin.chung@samsung.com
^{||} Electronic supplementary information (ESI) available: See DOI: 10.1039/D4TC00543E



JI TECH BOASTS
OUTSTANDING



TECHNOLOGY
AND PRODUCTS

Chapter 2.

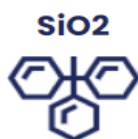
Business Area

1. PRECURSOR for Semiconductor
2. PHOTOMASK CASE for FPD
3. OLED MATERIALS

01 PRECURSOR for Semiconductor

주요 프리커서 생산제품

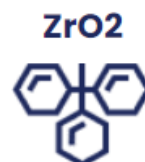
Si-precursor



BDEAS
 BTBAS
 DIPAS
 TDMAS
 TEOS
 HCDS
 SiCl₄

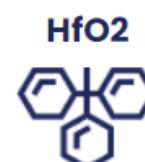
4MS
 OMCTS
 DIS (New)
 TSA(New)

Zr-precursor



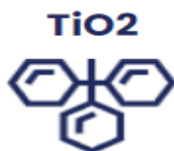
TEMAZr
 TDMAZr
 Cp-Zr

Hf-precursor



TEMAHf
 TDMAHf
 Cp-Hf

Metal-precursor



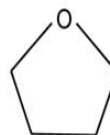
TDMATi
 CCTBA
 CpCo(CO)₂
 PDMATa
 Cp*Ti(OMe)₃
 TBTEMNb(New)
 TDMASn(New)

Solar Cell-precursor



POCl₃
 BBr₃

Inhibitor



THF
 CPME
 Pyridine
 Octane
 DBE
 Xylene

ETC



TiCl₄
 n-Butyllithium

년도별 매출

Precursor	2020	2021	2022	2023	2024	2025(E)	2026(E)	2027(E)
매출(억원)	172.3	179.6	322.7	320.8	463.1	648.0	780.0	900.0
Sales Growth %		4.2%	79.7%	-0.6%	44.4%	39.9%	20.4%	15.4%

- 25년부터 TSA 등 신규 제품 매출 발생
 (공장 건설 중, 하반기 매출 발생 예상)
 - 신규 고객사 확보에 따른 매출 증가 예상
 (미국, 대만 향)

02 PHOTOMASK CASE for FPD

마스크 케이스용 대전방지 소재개발(특허보유)을 통한 마스크 케이스 글로벌 스탠다드 구축

- HOYA, PKL, S&S Tech, ULCOAT, Newway Photomask 등 글로벌 마스크 고객사 확보

— 포토마스크 공정



포토마스크 공정과정

쿼츠(Quartz) 마스크

Blank, Photo mask의 원재료 합성석영유리



블랭크(Blank) 마스크

패턴이 노광되기 전의 마스크로, 쿼츠에 금속박막 필름이 증착되고 감광액이 도포



포토(Photo) 마스크

블랭크마스크를 이용하여 노광,현상 및 검사와 같은 과정을 통해 포토마스크 제조

End User

포토마스크를 공정·이송하기 위해 케이스 필수



— 제이아이테크 포토마스크케이스 제품



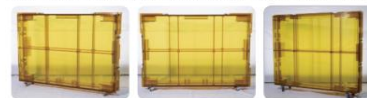
전공정 공통 제품



쿼츠/블랭크 제품



포토 제품



연도별 매출

Mark	2020	2021	2022	2023	2024	2025(E)	2026(E)	2027(E)
매출(억원)	7.9	14.8	24.1	44.6	64.7	70.0	75.0	80.0
Sales Growth %		86.3%	62.8%	85.1%	45.1%	8.3%	7.1%	6.7%

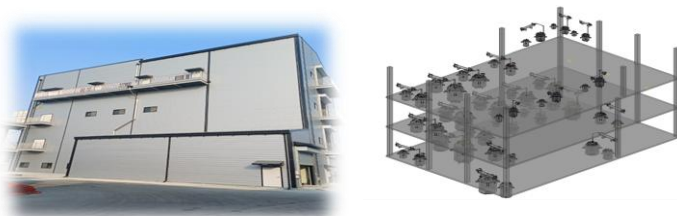
- 해외 고객사 다변화를 통한 매출 증가

03 OLED MATERIALS

합성 / 정제 시설

합성&정제 설비

SUS Reactor : 6EA
G/L Reactor : 6EA
Vacuum Dryer : 4EA



예상 양산 시점 : 2025. 3Q

"S"社, "L"社 向 OLED recycle, OLED 중간체 생산 예정

고객사 평가(Qualifying Test)

L사 25년 2분기 진행 예정

승화 시설

대량생산용(20ea, PVD)

Spec : Heating Zone : Total 16 ea (Up : 8 ea, Down : 8 ea)
Quartz Tube size : Out Dia. 300mm, Length 3.145mm

Pilot (1ea, PVD)

Spec : Heating Zone : total 7ea (Down : 7 ea)
Quartz Tube size : Out Dia. 100mm, Length 1,456mm



고객사 평가(Qualifying Test)

L사 완료, 현재 공급 중

년도별 매출

OLED	2020	2021	2022	2023	2024	2025(E)	2026(E)	2027(E)
매출(억원)	-	-	-	5.1	9.2	16.0	30.0	45.0
Sales Growth %					82.6%	73.2%	87.5%	50.0%

- 23년부터 승화 매출 발생
- 25년 하반기 합성 및 정제설비 완공에 따라 추가 신규 매출 발생 예상

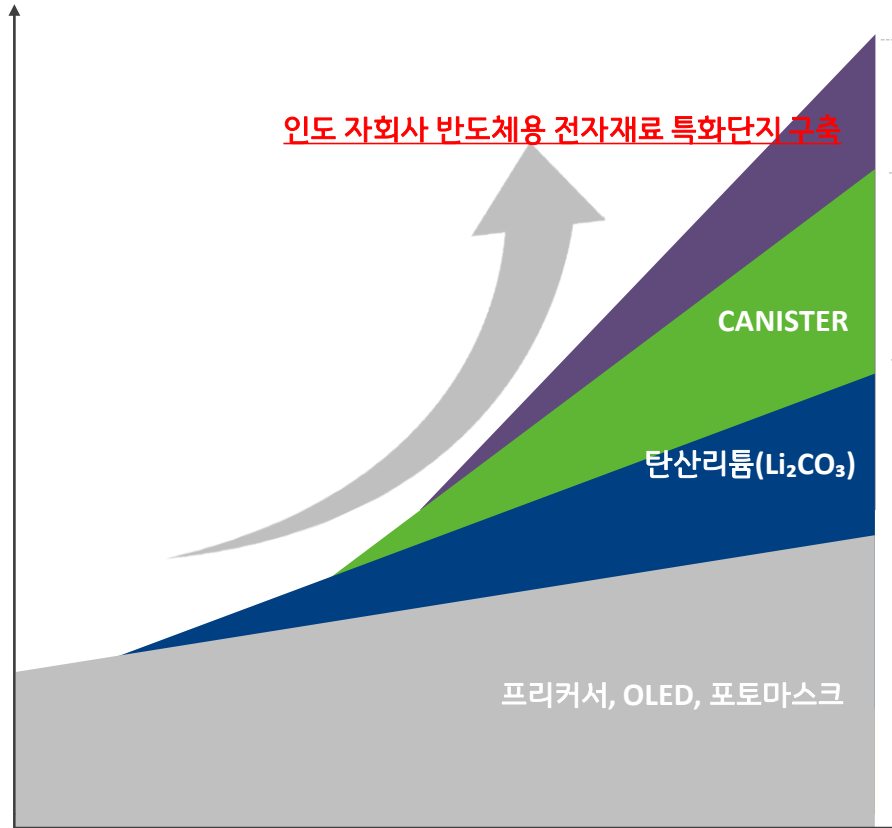
Chapter 3.

Growth Strategy

1. 주요 성장전략
2. 인도법인과 밸류체인 형성(프리커서, OLED 중간체 생산)
3. 탄산리튬(Li_2CO_3) 제조를 통한 2차전지 산업 진출
4. CANISTER



01 주요 성장 전략



인도 최초 반도체용 전자재료 제조 특화 단지 구축을 통한 글로벌 진출

- 인도법인 프리커서&OLED 재료 제조시설 구축
- 인도법인으로부터 가격 경쟁력 있는 원재료 안정적 수급

CANISTER 사업 진출

- 전해액, 첨가제 전용 Canister 사업 진출
- 반도체용 Canister로 확대

탄산리튬(Li₂CO₃) 제조를 통해 2차전지 산업 진출

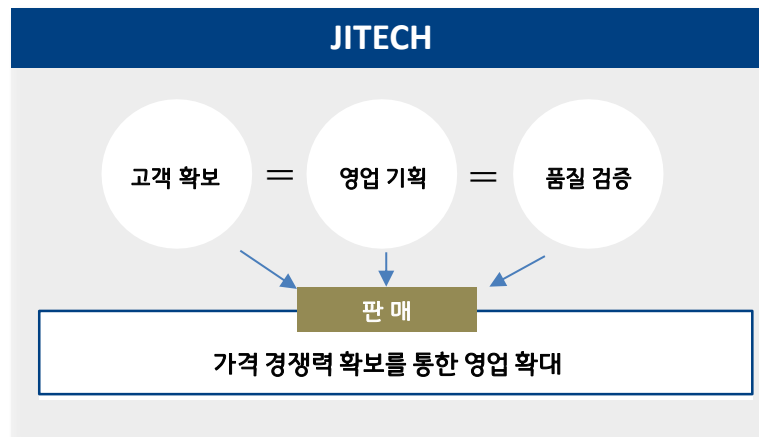
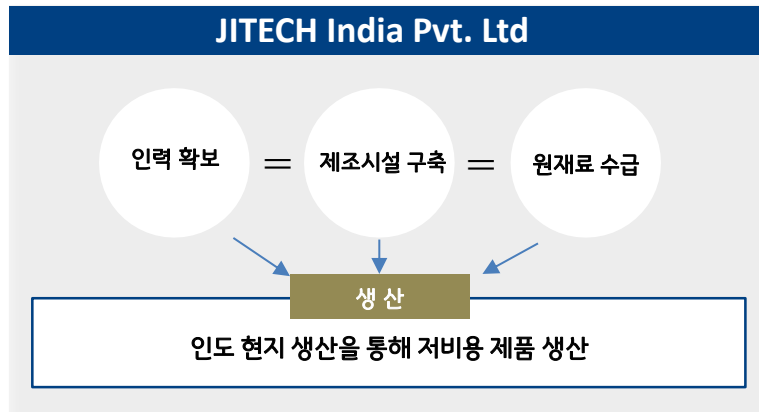
- 차세대 배터리 소재
- 자회사(제이아이카본엑스) CO₂와 프리커서 생산 부산물(LiCl)을 통한 탄산리튬 제조

기존 핵심 제품 역량 증가

- 신규 공장 구축(프리커서, OLED)
- 프리커서 신규 아이템 출시 및 신규 고객 확보
- OLED 신규 고객사 확보
- 포토마스크 케이스 시장에서의 안정적인 지위 유지

02 인도 자회사 반도체용 전자재료 특화단지 구축

인도 최초 반도체용 전자재료 제조 특화 단지 구축을 통한 글로벌 진출



인도 현지 반도체 프리커서 및 OLED 소재 제조 시설 구축

- 현재 총 고용인원 40명, 이중 화학전공 석/박사 23명 (25년내 추가 20명 채용 예정)
- 전체 생산 시설 7개동(PB1~PB7) 중 PB1 6월 준공예정
- 주요 원료 공급처 확보 완료

인도 생산 주요 제품

- n-Butyllithium, Hf Precursor, Zr Precursor, Ti Precursor, Nb Precursor, OLED 소재

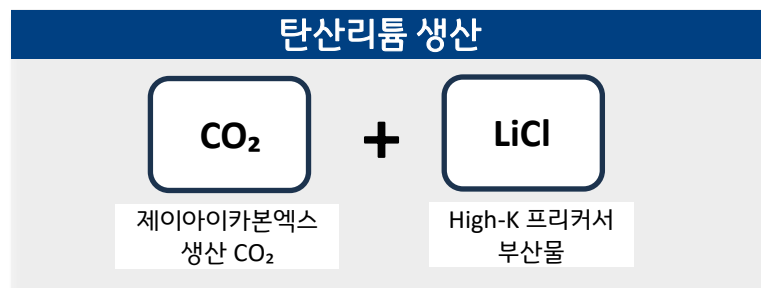
협력을 통한 매출 증가

- JITECH에서 영업, 품질 보증
- 원가절감 효과

인도 법인 향후 추진 계획

- 향후 타 고객사 향 OEM 생산을 위한 공장 설계 완료 (PB2~PB7 생산 가동을 위한 유틸리티, 품질분석실, 기타 공용 시설 등은 PB1과 같이 완공 예정)
- 2026년 부터 PB2~PB7 착공, 고객사에 분양 예정
- 프리커서의 반도체용 전자재료 제조시설 전문 단지 구축

03 Recycling 탄산리튬(Li_2CO_3) 제조를 통해 2차전지 산업 진출



탄산리튬(Li_2CO_3)

1kg 탄산리튬 생산 시 = (CO_2 0.6kg + LiCl 1.1kg)

사업화 로드맵

- R&D : 현재 R&D 개발 완료, 2025년 파일럿 공정 구축 검토
- 시범생산 : 2026년 상반기 시범생산 시작 (200ton)
- 상업생산 : 2027년 하반기 상업생산 시작 (1,000ton~)

탄산리튬 핵심 원료 확보

- CO_2 : 자회사인 제이아이카본엑스로 부터 공급
- LiCl : High-K 프리커서 부산물
 - JI-Tech : 년 100ton (확보)
 - U사 : 년 500ton (확보)
 - A사, D사 : 년 1,300ton (진행예정)

반도체 소재기업은 현재 High-K 프리커서 생산 시 부산물로 발생하는 LiCl 를 유상으로 폐기 처리

생산 CAPA

- 위치 : 새만금산업단지(2차전지 특화단지) 3공장 부지내
- 생산 CAPA : 탄산리튬 연간 2,000ton 규모 생산시설

기대효과

- 매출 : 연간 300억 예상
- 기타 : 자회사 제이아이카본엑스 탄소배출권 발생

03 CANISTER

Total Manufacturing System(일괄생산시스템) 생산 구축

와다
등
일본업체

대명공업금속
지오엘리먼트
등
국내업체
(외주공정多)

머시너리
하이신다
등
중국업체

중국산 저가제품으로 이동 중, 지역내 수요증가에 따른 공급부족과 품질, 납기 이슈 발생

JITECH CANISTER

- 가격경쟁력 확보
- 품질, 납기 경쟁력 확보
- 다품종, 소량생산가능



전해액/
첨가제용
(200L)



반도체
프리커서용
(50cc~200L)

저렴한 가격과 품질을 동시에 충족하는
Canister 제조 및 판매

JITECH Canister 경쟁력

- 인도 현지 생산에 의해 저렴한 원가, 이를 통한 중국업체와의 가격 경쟁력 확보
- JITECH에서 인증, 품질 보증에 따른 제품 신뢰도 향상
- 엔캠, 이피캠텍, 천보, 백광산업 등 주요 전해액 및 첨가제 업체가 새만금산업단지 입주에 따른 고객 확보 용이

Canister 생산 진행현황

- 인도 현지 생산시설 구축 (25.6월 완공)
- Canister 제작 국내 기술인원 파견,
- 2025년 8월 양산 시작

생산 CAPA

- 현재 월 1000대 생산(전해액용 기준)
- 2026년 반도체 프리커서용 월 500대 확대 예정

기대효과

- 매출 : 연간 200억 매출 예상

Appendix

1. 성장 연혁
2. 요약 연결재무제표
3. 요약 별도재무제표

JI TECH BOASTS OUTSTANDING
TECHNOLOGY AND PRODUCTS

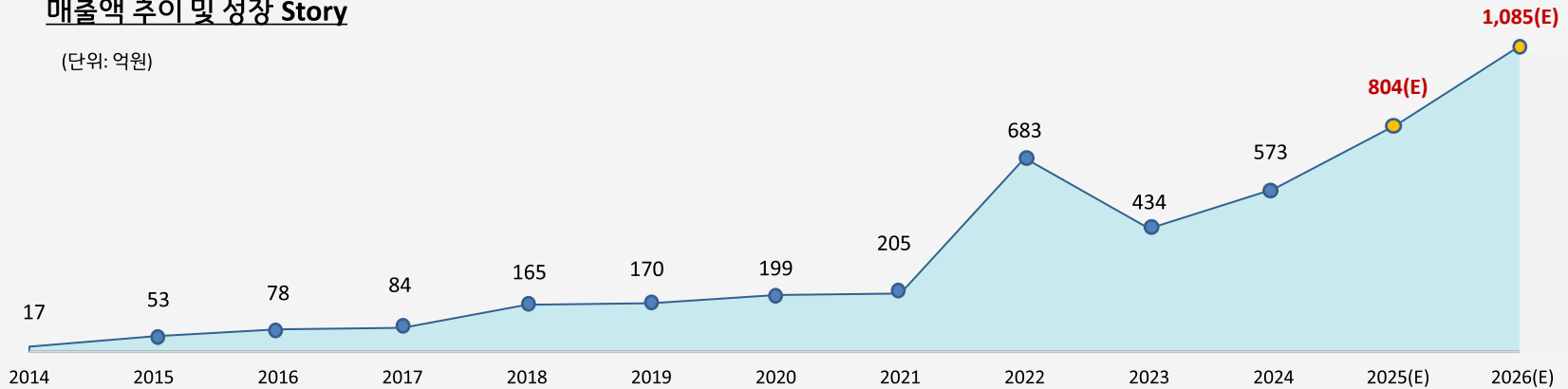


01. 성장 연혁

반도체용 프리커서, 자회사와 벨류체인을 기반으로 외형성장 본격화

매출액 추이 및 성장 Story

(단위: 억원)

(설립 ~ 2015)
[프리커서 시장 진출](2016 ~ 2019)
[사업다각화](2020 ~ 2022)
[외형 성장](2023 ~ 2024)
[신사업 확장](2025 ~)
[매출 확장]

- 2014
- (주)제이아이테크 설립
 - 벤처기업 인증
 - ISO9001 & ISO14001 인증

- 2015
- UP Chemical 협력사 등록
 - SK Hynix 2차 협력사 등록

- 2017
- Kioxia (TOSHIBA) 2차 협력사 등록

- 2018
- 포토마스크케이스 사업부 설립

- 2019
- 포토마스크케이스 공장 완공

- 2020
- 인도 법인 설립 (JITECH India Pvt. Ltd)

- 2021
- 2공장 완공

- 2022
- KOSDAQ 상장
 - 3공장 부지매입

- 2023
- CCUS 사업 진출
 - OLED business 사업 확대

- 2024
- 3공장 준공(원재료 소분시설)

- 2025
- OLED 합성 및 정제공장 완공
 - TSA 제조시설 완공, 판매 시작
 - JITI(India) 생산공장 완공(PB1)
 - 제이아이카본엑스드라이아이스 공장 완공
 - 신규 R&D Center 건립
 - Canister 판매 시작
- 2026 ~
- 탄산리튬 Pilot 설비 구축
 - 3공장 신규 프리커서 제조시설 완공
 - JITI(India) 생산공장 건설 (PB2~PB7)
 - 탄산리튬 공장 구축 (3공장내)

02. 요약 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)					
구분	2020	2021	2022	2023	2024
유동자산	11,594	20,295	59,855	39,740	46,841
비유동자산	12,377	15,131	25,270	65,820	75,104
자산총계	23,971	35,426	85,125	105,560	121,945
유동부채	9,847	11,171	22,564	26,027	28,233
비유동부채	1,404	825	466	14,839	23,290
부채총계	11,251	11,997	23,030	40,866	51,523
자본총계	12,719	23,429	62,095	64,694	70,422
유동비율	117.70%	181.70%	265.27%	152.69%	165.91%
부채비율	88.50%	51.20%	37.09%	63.17%	73.16%

요약 연결포괄손익계산서

(단위: 백만원)					
구분	2020	2021	2022	2023	2024
매출액	19,893	20,497	68,282	43,363	57,293
매출원가	12,886	12,548	53,365	32,909	41,094
매출총이익	7,007	7,949	14,917	10,454	16,198
판매비와 관리비	2,804	2,321	3,524	6,368	7,493
영업이익	4,203	5,628	11,394	4,086	8,705
영업이익율	21.13%	27.46%	16.69%	9.42%	15.19%
당기순이익	3,826	5,498	10,924	3,290	8,080
순이익율	19.20%	26.80%	16.00%	7.59%	14.10%

03. 요약 별도재무제표

요약 별도재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
유동자산	11,594	20,295	58,710	32,328	40,583
비유동자산	12,377	15,131	25,747	56,147	71,564
자산총계	23,971	35,426	84,457	88,476	112,146
유동부채	9,847	11,171	22,338	23,794	24,005
비유동부채	1,404	825	401	589	12,752
부채총계	11,251	11,997	22,739	24,383	36,757
자본총계	12,719	23,429	61,718	64,093	75,389
유동비율	117.70%	181.70%	262.83%	135.87%	169.06%
부채비율	88.50%	51.20%	36.84%	38.04%	48.76%

요약 별도포괄손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
매출액	19,893	20,497	68,291	42,531	56,083
매출원가	12,886	12,548	54,628	33,162	37,005
매출총이익	7,007	7,949	13,662	9,370	19,077
판매비와 관리비	2,804	2,321	3,272	5,004	5,429
영업이익	4,203	5,628	10,390	4,366	13,648
영업이익율	21.13%	27.46%	15.21%	10.26%	24.34%
당기순이익	3,826	5,498	10,531	3,850	14,303
순이익율	19.20%	26.80%	15.42%	9.05%	25.50%

04. 2025년 1분기 요약 재무정보

요약 연결재무정보

(단위: 백만원)

구분	2025.1분기	2024	2023
유동자산	43,021	46,841	39,740
비유동자산	80,414	75,104	65,820
자산총계	123,435	121,945	105,560
유동부채	30,535	28,233	26,027
비유동부채	23,454	23,290	14,839
부채총계	53,989	51,523	40,866
자본총계	69,446	70,422	64,694

구분	2025.1분기	2024.1분기	증감
매출액	12,663	13,362	-5.2%
매출총이익	4,067	4,106	-0.9%
판관비	1,560	2,055	-24.1%
영업이익	2,507	2,051	+22.2%
분기순이익	2,353	1,667	+41.2%
영업이익율	19.8%	15.3%	+4.5%p
순이익율	18.6%	12.5%	+6.1%p

요약 별도재무정보

(단위: 백만원)

구분	2025.1분기	2024	2023
유동자산	37,467	40,583	32,328
비유동자산	76,595	71,563	56,148
자산총계	114,062	112,146	88,476
유동부채	25,809	24,005	23,794
비유동부채	12,907	12,752	589
부채총계	38,716	36,757	24,383
자본총계	75,346	75,389	64,093

구분	2025.1분기	2024.1분기	증감
매출액	12,632	13,445	-6.0%
매출총이익	4,329	5,165	-16.2%
판관비	1,223	1,200	+1.9%
영업이익	3,106	3,965	-21.7%
분기순이익	3,141	3,211	-2.2%
영업이익율	24.6%	29.5%	-4.9%p
순이익율	24.9%	23.9%	+1.0%p